

	<h2 style="color: red;">FDB082N15A</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB082N15A
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 117A D2PAK
	Datenblätter:  FDB082N15A.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 44121 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB082N15A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 117A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	44121 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	294W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB082N15AFSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6040pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 117A (Tc) 294W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	117A (Tc)

FDB082N15A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB082N15A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB082N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB082N15A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB088N08_F141 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB075N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A D2PAK</p>	 <p>FDB075N15A-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 110A D2PAK</p>	 <p>FDB075N15A_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB075N15A_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDB082N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 117A D2PAK</p>	 <p>FDB088N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>	 <p>FDB075N15A_SN00284 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V</p>	 <p>FDB088N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>

FDB082N15A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB082N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB082N15A Datenblatt	FDB082N15A-Datenblätter	FDB082N15A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB082N15A
FDB082N15A Electronic	FDB082N15A-Komponenten	FDB082N15A-Verteiler	FDB082N15A-Bild	FDB082N15A-Teil
FDB082N15A Preis	FDB082N15A Hersteller	FDB082N15A Bild	FDB082N15A Aktie	FDB082N15A Inventar
FDB082N15A Neu	FDB082N15A Original	FDB082N15A garantiert	FDB082N15A RFQ	FDB082N15A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited